

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成18年9月28日(2006.9.28)

【公開番号】特開2005-236118(P2005-236118A)
 【公開日】平成17年9月2日(2005.9.2)
 【年通号数】公開・登録公報2005-034
 【出願番号】特願2004-44788(P2004-44788)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)
H 0 1 L 27/08 (2006.01)
H 0 1 L 21/762 (2006.01)
H 0 1 L 21/76 (2006.01)
H 0 1 L 21/822 (2006.01)
H 0 1 L 27/04 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 0 2 M
 H 0 1 L 27/08 3 3 1 E
 H 0 1 L 21/76 D
 H 0 1 L 21/30 5 2 2 Z
 H 0 1 L 21/76 M
 H 0 1 L 27/04 A

【手続補正書】
 【提出日】平成18年8月14日(2006.8.14)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0031
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0031】

続いて、素子形成領域100及びマーク形成領域150のシリコン酸化膜20上に窒化膜としてシリコン窒化膜22を同時に形成する。シリコン窒化膜22を、例えば、ジクロロシラン(SiH_2Cl_2)ガスを主成分とするLP-CVD(Low Pressure-Chemical Vapor Deposition)法を用いて、60~150nmの膜厚で形成する。ここでのシリコン窒化膜22の膜厚は、後工程で素子形成領域100及びマーク形成領域150の第2のシリコン層16に酸化部を選択酸化によって形成する際の酸化阻止用マスクとしてはもとより、凹部を形成する際の耐エッチングマスクとして機能する程度の膜厚とする(詳細後述)。